

スパッタ装置

研究開発から生産まで対応

研究開発装置 EB1000 / 生産装置 EB1100, EC7000, IC1060

EB1000



実験・研究開発に最適なスパッタ装置
教育用装置としてもお勧め

特長

- ・小径(φ 2")カソードで最大3元同時成膜が可能
- ・トレイ搬送により多種多様な基板に対応可能
- ・小スペースに設置可能

EB1100



高温成膜や低温成膜も可能なスパッタ装置
研究から少量生産まで対応

特長

- ・φ 4"(最大4基)、φ 12.5"(1基)カソードに多種多様なターゲットを搭載可能
- ・トレイ搬送により多種多様な基板に対応可能
- ・搬送から成膜まで全自動運転

EC7000/7001



製品向けスパッタ装置
各種デバイス開発から量産まで対応

特長

- ・φ 4"(最大4基)、φ 12.5"(1基)カソードに多種多様なターゲットを搭載可能
- ・トレイ搬送により多種多様な基板に対応可能
- ・カセット室/トランスファ室装備

IC1060



生産向けスパッタ装置
電極・配線・UBMなどに対応

特長

- ・ウェハーサイズφ150 mm、φ 200 mm
- ・最大6チャンバ搭載のクラスター装置 (PVD×4(Max)、Etch、Heat)
- ・OHTやオンラインも対応

CANON ANELVA CORPORATION

スパッタ装置

先端半導体向け量産装置

FC7100 , NC7900 , IC7500 , BC7300

FC7100



HKMG（ゲートファースト方式）のデファクトスタンダード

特長

- ・ゲート絶縁膜上への低ダメージ成膜
- ・原子層レベルの面内均一性と膜厚制御性
- ・メタルモード/ポイズンモードの両放電領域における安定した反応性スパッタ

NC7900



原子層レベルの面内均一性と膜厚制御性を実現

特長

- ・膜厚やプラズマの状態をリアルタイムでモニタリングする機能により量産中の膜厚・膜質変動を自動で補正
- ・超高真空雰囲気です数十層の多層膜を一貫成膜（最大32カソード）
- ・MRAM向け極薄多層膜の量産実績を様々な工程に応用

IC7500



最先端DRAMの量産標準機

特長

- ・量産実績に基づく高い生産性と安定性
- ・平行平板カソードによる金属薄膜の高速成膜
- ・マグネット位置をIn-situで変更できる独自のカソードにより、異なる成膜条件やクリーニング条件の連続処理が可能

BC7300



スパッタ膜を利用した接合技術（原子拡散接合法:Atomic Diffusion Bonding）

特長

- ・スパッタ膜により接合界面に多彩な機能を付加することが可能
- ・高真空中でスパッタ膜成膜～接合までを一貫で処理することで、清浄な接合界面を実現
- ・無加熱/無加圧で強固な接合

CANON ANELVA CORPORATION